05.3

Индуцируемые электрическим полем фазовые переходы в $\langle 001 \rangle$ ориентированных монокристаллах PZN—9PT и PMN—35PT

© Л.С. Камзина, И.П. Раевский, Е.В. Снеткова

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург E-mail: kamzin@mail.ioffe.ru НИИ физики Ростовского государственного университета, Ростов-на-Дону

Поступило в Редакцию 2 апреля 2006 г.

Исследовано влияние постоянного электрического поля $(0 < E < 5\,\mathrm{kV/cm})$ на оптическое пропускание монокристаллических соединений PZN-9PT и PMN-35PT, принадлежащих к морфотропной области. Обнаружено, что при температурах, близких к температуре морфотропного фазового перехода, в электрическом поле в составах PZN-9PT индуцируются две новые промежуточные моноклинные фазы M_a и M_c , а в PMN-35PT — только одна. Показано, что фаза M_c в PMN-35PT является неоднородной, а переход из M_c в тетрагональную фазу носит непрерывный характер. Построены E-T фазовые диаграммы для обоих кристаллов. Полученные результаты объясняются в рамках теории Девоншира для сильно ангармоничных кристаллов.

PACS: 77.80.Bh, 78.20.Ci

сегнетоэлектриков-Монокристаллы растворов твердых релаксоров (100-x)PbZn_{1/3}Nb_{2/3}O₃-xPbTiO₃ (PZN-xPT)(100-x)PbMg_{1/3}Nb_{2/3}O₃-xPbTiO₃ (PMN-xPT), обладающие пьезоэлектрических огромными значениями коэффициентов $(d_{33} > 2500 \,\mathrm{pC/N})$ и коэффициентов электромеханической связи $(k_{33} > 94\%)$, активно исследуются как материалы нового поколения электромеханических устройств, которые могут привести к революции в электромеханическом преобразовании энергии [1,2]. Кроме того, эти материалы привлекательны и в электрооптической технологии из-за больших электрооптических коэффициентов.

Наиболее высокие электромеханические свойства у кристаллов PZN-xPT и PMN-xPT наблюдаются вблизи фазовой границы между ромбоэдрической и тетрагональной фазами, так называемой морфотропной фазовой границы (МФГ), которая является общей чертой фазовых x, T диаграмм твердых растворов $PbMeO_3-PbTiO_3$ [3,4]. В реальных кристаллах и керамиках четкая МФГ размывается и, как правило, говорят о морфотропной области (МО), ширина которой зависит от условий получения образцов. В кристаллах PZN-xPT и PMN-xPT обычно MO наблюдается при 8 < x < 10 и 31 < x < 37соответственно. Причины наличия экстремума пьезосвойств у составов, принадлежащих к МО, а также того факта, что наибольшие значения пьезокоэффициентов у кристаллов наблюдаются при поляризации вдоль направления [001], несмотря на то что полярная ось в них лежит вдоль направления [111] [1,2], уже длительное время являются предметом дискуссий. В последние годы наибольшее признание получили модели, связывающие огромные величины электромеханического отклика в подобных соединениях, с наличием на х, Т диаграмме одной или нескольких промежуточных моноклинных фаз между ромбоэдрической и тетрагональной фазами, что облегчает поворот вектора поляризации в электрическом поле [5,6].

Согласно модели, предложенной в [6], приложение поля вдоль направления [001] в ромбоэдрических кристаллах индуцирует вращение вектора поляризации в (110) плоскости из ромбоэдрической (R(X)) в тетрагональную (T) фазу через промежуточную третью фазу, либо моноклинную M_a или M_c [7], либо более сложную, представляющую смесь орторомбической (O) и моноклинной фаз [8]. Вопрос о точной симметрии этих промежуточных фаз в составах с разными х является дискуссионным. Эта симметрия зависит от того, по какому пути вращается вектор поляризации при переходе из R(X) в T фазу. Особенно много разногласий возникает о симметрии и даже числе промежуточных фаз для составов, принадлежащих к МО. Так, авторы работ [9,10], используя нейтроно- и рентгенодифракционные методы исследований, показали, что в составе PZN-8PT из MO при увеличении электрического поля вектор сначала следует по направлению $R(X)-M_a-T$, а затем скачком идет по новому пути $R(X)-M_a-M_c-T$. При уменьшении электрического поля вектор поляризации вращается от тетрагонального направления [001] до орторомбического через M_c фазу и начальное ромбоэдрическое состояние после снятия поля не восстанавливается. В то же время в работе [8] указано на существование

O-фазы между R(X) и T фазами, которая очень близка по энергии к M_c фазе, и их трудно различить (фаза O является предельным случаем M_c фазы, когда $a_m=c_m$). Расчеты из первых принципов, проведенные в работе [11], объяснили существование низкосимметричных моноклинных фаз в сегнетоэлектрической системе со структурой перовскита вблизи МФГ в рамках теории Девоншира для сильно ангармонических кристаллов, где важную роль играют члены высоких порядков.

Фазовый состав MO в системе PMN-xPT исследован не так подробно, как в PZN-xPT, и данные о симметрии фаз еще более противоречивы. Рентгеновские дифракционные исследования, проведенные в [12], показали, что принадлежащие MO составы PMN-35PT, поляризованные вдоль [001], имеют M_a симметрию, а неполяризованные чисто ромбоэдрическую симметрию. Это противоречит результатам более ранеей работы [13], в которой сообщалось о ромбических и тетрагональных доменах. В то же время и нейтроно- и рентгенодифракционные исследования обнаружили существование моноклинной фазы типа M_c в неполяризованных PMN-35PT при низких температурах, а в РМN-34РТ — при комнатной температуре. Основываясь на результатах синхротронных исследований керамических порошков составов из МО [14], авторы сделали вывод, что фаза M_c не существует как отдельная фаза ни в одном из изученных образцов. В соединении PMN-33PT при комнатной температуре сосуществуют M и T фазы, а в PMN-37PT при низких температурах сосуществует смесь фаз M_c и Т в соотношении 55:45, в то время как при комнатной температуре преобладающей является T фаза. Более сложная картина наблюдается в составах РМN-35РТ, в которых, согласно данным [14], при комнатной температуре сосуществуют 3 фазы: моноклинная и орторомбическая $(\sim 35\%)$, параметры решетки которых при $300\,\mathrm{K}$ невозможно различить, и тетрагональная фаза ($\sim 65\%$). Противоположная точка зрения высказана в недавно появившейся работе [15]. Авторы, используя оптический поляризационный микроскоп и измерения двупреломления, пришли к выводу, что в соединениях PMN-xPT с x = 0.3-0.47 не существует фазы с тетрагональной симметрией даже при высоких температурах.

Все эти результаты указывают на то, что фазовый состав кристаллов PZN-xPT и PMN-xPT, принадлежащих к MO, очень сложен и для полного понимания превращений, наблюдаемых в электрических полях, необходимы различные методики исследования, в том числе и оптические.

В данной работе мы приводим результаты измерений оптического пропускания кристаллов PZN-9PT и PMN-35PT, принадлежащих к MO, при приложении электрического поля напряженностью $0 < E < 5 \, \mathrm{kV/cm}$.

Монокристаллы PZN-9PT и PMN-35PT выращивались из раствора в расплаве [16,17]. Температура Кюри для PZN-9PT $T_c\sim 443-453\,\mathrm{K}$, а морфотропного фазового перехода между R(X) и T фазами $T_{tr}\sim 333-343\,\mathrm{K}$ [18]. Для PMN-35PT $T_c\sim 435\,\mathrm{K}$, $T_{tr}\sim 365-375\,\mathrm{K}$ [17]. Оптическое пропускание изучалось при фиксированных температурах вблизи T_{tr} в режиме увеличения электрического поля. Перед каждым измерением кристалл нагревался выше T_c с целью деполяризации, затем охлаждался без поля до комнатной температуры, после чего нагревался до температуры измерения. Температура стабилизировалась и прикладывалось электрическое поле разной напряженности E в направлении [001], свет распространялся вдоль [100]. Для оптических измерений использовался He-Ne-лазер.

На рис. 1 приведены зависимости оптического пропускания (I)от электрического поля для кристалла PZN-9PT при некоторых фиксированных температурах, близких к T_{tr} . Из рисунка четко видна эволюция I в электрическом поле, связанная с индуцированными фазовыми переходами. Здесь необходимо заметить, что наблюдаемые изменения I не связаны с возникновением тетрагональной фазы, так как используемая напряженность поля была недостаточна для ее индуцирования [9]. В малых электрических полях оптическое пропускание для всех температур практически неизменно (кривые 1-4). При увеличении поля до некоторого порогового значения наблюдается резкое уменьшение пропускания, связанное с индупированным фазовым переходом в другую фазу, по-видимому M_a . Так как из наших оптических измерений невозможно определить симметрию возникающих фаз, то в дальнейшем мы будем использовать обозначения фаз, предложенные в работах [9,19]. Поле, при котором индуцируется эта фаза, тем меньше, чем ближе температура измерения к температуре морфотропного фазового перехода T_{tr} (рис. 1, кривые 1-3). При дальнейшем увеличении поля наблюдается еще один индуцированный фазовый переход в новую фазу, по-видимому в M_c . Область существования фазы M_a тем больше, чем дальше температура измерения от T_{rt} (кривые 2-3). При температурах, далеких от T_{rt} (1), в исследуемых электрических полях мы не наблюдали индуцирования фазы M_c . Ступенчатое возрастание оптического

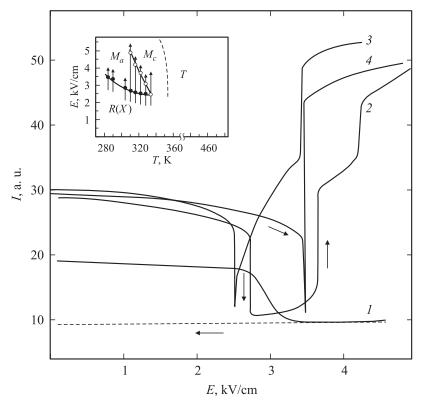


Рис. 1. Температурные зависимости оптического пропускания (I), снятые при увеличении электрического поля при фиксированных температурах (K), для кристалла PZN-9PT: I — 289, 2 — 320, 3 — 332, 4 — 346; на вставке E-T фазовая диаграмма. Стрелки указывают направление приложения электрического поля. Точки соответствуют температурам переходов и полям, определенным для каждого конкретного измерения. Пунктирная линия соответствует предполагаемой фазовой границе между M_c и T фазами.

пропускания с изменением поля при индуцировании фазы M_c (2,3) связано, скорее всего, с неоднородностью фазы. При температурах измерения вблизи T_{rt} кристалл из R(X) фазы сразу переходит в фазу M_c (3,4). При этом переходе наблюдается резкий минимум

оптического пропускания, подтверждающий перколяционный характер индуцированного полем перехода из фазы R(X) в моноклинную фазу, и возникновение крупномасштабной структуры, обнаруженные нами в работе [20]. Если фазовый переход проходит по перколяционному типу, то средний размер кластера новой фазы на пороге протекания стремится к размеру образца, образуется крупномасштабная неоднородная структура и фазовый переход должен сопровождаться появлением аномально узкого пика интенсивности MPC и, следовательно, минимумом оптического пропускания [21].

Фазы M_a и M_c , индуцированные полем в кристаллах PZN-9PT, остаются стабильными и после снятия поля, о чем свидетельствуют пунктирная линия на кривой I и данные нашей работы [18], т.е. кристалл остается в моноклинной фазе даже после снятия поля. Это согласуется с результатами работы [22], в которой сообщалось, что фаза M_a остается стабильной при комнатной температуре более 2 недель после снятия поля.

Используя данные рис. 1, мы построили E-T фазовую диаграмму, которая приведена на вставке рис. 1. При низких температурах R(X) фаза с ростом поля необратимым образом переходит в M_a фазу, которая при более высоких полях трансформируется в M_c фазу. По мере приближения температуры к T_{rt} область существования фазы M_a схлопывается и кристалл сразу из фазы R(X) при некотором пороговом поле переходит в M_c фазу. Как только в кристалле PZN-9PT возникает M_c фаза, R(X) и M_a фазы в нем долго не восстанавливаются и только уже при более высоких полях имеет место M_c-T фазовый переход. Существование промежуточной M_a фазы подтверждается и выводами теории Девоншира [11], учитывающей члены 8 порядка. Согласно этой теории, фазовый переход между R(X) и M_c фазами может осуществляться только через промежуточную O или M_a фазы.

Другая картина наблюдается для состава PMN-35PT, также принадлежащего к MO. Рис. 2 иллюстрирует изменение оптического пропускания при приложении к кристаллу электрического поля. Так же как и в PZN-9PT, в PMN-35PT переход в моноклинную фазу при увеличении E происходит резко и является переходом 1-го рода. Так как фазы M_c и O очень близки по энергиям, то требуется очень маленькое поле, чтобы индуцировать $O-M_c$ фазовый переход. Интересно отметить поведение оптического пропускания при переходе из моноклинной в тетрагональную фазу. Из рисунка видно, что M-T

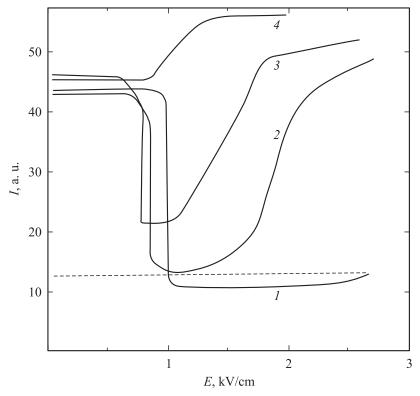


Рис. 2. Температурные зависимости оптического пропускания (I), снятые при увеличении электрического поля при фиксированных температурах (K), для кристалла PMN-35PT: I-365, 2-370, 3-375, 4-381.

переход носит непрерывный характер. Такое поведение можно объяснить двумя причинами. Согласно теории Девоншира, учитывающей члены 8-го порядка, M_c-T фазовый переход может быть 2-го рода и тогда не должно наблюдаться сосуществования фаз. Однако в нашем случае фазы сосуществуют, а, согласно этой же теории, переход из O в T фазу является переходом 1-го рода и тогда присутствие O фазы также может объяснить широкую область сосуществования M_c-T фаз. Хотя из наших измерений невозможно определить симметрию возникающих

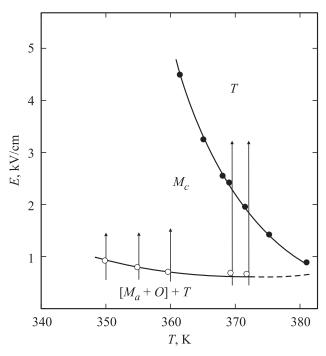


Рис. 3. E-T фазовая диаграмма для кристалла PMN-35PT, полученная из оптических измерений, при увеличении электрического поля после ZFC. Стрелки указывают направление приложения электрического поля. Точки соответствуют температурам переходов и полям, определенным для каждого конкретного измерения.

фаз, но, учитывая наблюдаемый непрерывный характер перехода и выводы теоретической работы [11], можно с уверенностью говорить о переходе именно в тетрагональную фазу и о сосуществовании фаз в этом соединении. В отличие от PZN—9PT переход в тетрагональную фазу происходит в достаточно низких электрических полях, и мы его легко можем наблюдать в условиях нашего эксперимента.

Используя данные рис. 2, была построена фазовая диаграмма, приведенная на рис. 3. Как видно из диаграммы, при температуре $T_{rt}\sim 373-375\,\mathrm{K}$ не весь объем кристалла PMN-35PT переходит в T

фазу, в нем остается небольшая доля M_c . При дальнейшем повышении температуры немного выше T_{rt} доля M_c фазы еще уменьшается, и поэтому в пределах точности нашего эксперимента не обнаружено изменения пропускания при этом переходе (рис. 2, кривая 4). И только при температурах выше T_{rt} кристалл PMN-35PT переходит в однофазное тетрагональное состояние. Здесь необходимо отметить разницу в поведении соединений PZN-9PT и PMN-35PT при T_{rt} . Если PZN-9PT при некотором пороговом поле сразу, минуя фазу M_a , переходит в однофазное состояние (M_c фаза), то в PMN-35PT, помимо тетрагональной фазы, остается доля промежуточной моноклинной фазы, т. е. наблюдается сосуществование фаз.

Таким образом, в работе впервые проведены оптические исследования фазовых переходов, индуцированных электрическим полем, в монокристаллических соединениях PZN-9PT и PMN-35PT, принадлежащих к МО. Обнаружено, что в кристаллах PZN-9PT при температурах, близких к T_{tr} , в электрическом поле индуцируются 2 новые промежуточные фазы M_a и M_c , а PMN-35PT — только одна. Показано, что в обоих кристаллах фаза M_c остается основным состоянием кристалла и после снятия электрического поля. Высказано предположение, что присутствие третьей орторомбической фазы может объяснить непрерывный характер перехода между M_c и T фазами в соединении PMN-35PT.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 05-02-17835 и 05-02-90568 ННС) и Президиума ОФН РАН.

Список литературы

- [1] Park S.-E., Shrout T.R. // J. Appl. Phys. 1997. N. 82. P. 1804–1808.
- [2] Luo H.S., Xu G.S., Xu H.Q. et al. // Jpn. J. Appl. Phys. Part 1. 2000. V. 39. P. 558.
- [3] Jaffe B., Cook W.R., Jaffe H. // Piezoelectric Ceramics. London: Academic Press, 1971.
- [4] Kuwata J., Uchino K., Nomura S. // Ferroelectrics. 1981. V. 37. P. 579-582.
- [5] Noheda B., Cox D.E., Shirane G. et al. // Appl. Phys. Lett. 1999. V. 74. P. 2059.
- [6] Fu H., Cohen R.E. // Nature (London). 2000. V. 403. P. 281-283.
- [7] Durbin B.K., Jacobs E.W., Hicks J.C. et al. // Appl. Phys. Lett. 1999. V. 74. P. 2848.

- [8] Noheda B., Cox D.E., Shirane G. et al. // Phys. Rev. Lett. 2001. V. 86. P. 3891–3894.
- [9] Noheda B., Zhong Z., Cox D.E. et al. // Phys. Rev. B. 2002. V. 65. P. 224101-7.
- [10] Ohwada K., Hirota K., Rehrig P. et al. // J. Phys. Soc. Jap. 2001. V. 70. P. 2778–2783.
- [11] Vanderbilt D., Cohen M.H. // Phys. Rev. B. 2001. V. 63. P. 094108-9.
- [12] Ye Z.-G., Noheda B., Dong M. et al. // Phys. Rev. B. 2001. V. 64. P. 184114–5.
- [13] Ye Z.-G., Dong M. // J. Appl. Phys. 2000. V. 87. P. 2312.
- [14] Noheda B., Cox D.E., Shirane G. et al. // Phys. Rev. B. 2002. V. 66. P. 054104–9.
- [15] Shuvaeva V.F., Glazer A.M., Zekria // J. Phys. Cond. Matter. 2005. V. 17. P. 5709–5723.
- [16] Xu J., Fan S., Lu B. et al. // Jpn. J. Appl. Phys. 2002. V. 41. P. 7000–7002.
- [17] Раевский И.П., Семенчев А.Ф., Емельянов А.С. и др. // Изв. РАН. Сер. Физ. 2005. Т. 69. С. 1034.
- [18] Камзина Л.С., Ху Ж., Ши М. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2005. Т. 81. С. 712–716.
- [19] Guo R., Cross L.E., Park S.E. et al. // Phys. Rev. Lett. 2000. V. 84. P. 5423.
- [20] *Камзина Л.С., Xu J., Shi M.* et al. // Письма в ЖТФ. 2004. Т. 30. В. 23. С. 62–69.
- [21] Камзина Л.С., Корженевский А.Л. // Письма в ЖЭТФ. 1989. Т. 50. С. 146– 149
- [22] Ohwada K., Hirota K., Rehrig P. et al. // Preprint cond.mat 2002. R0207726.